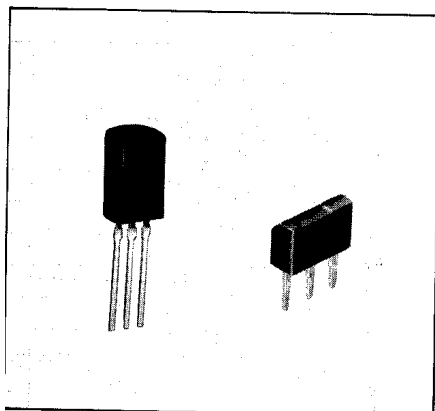
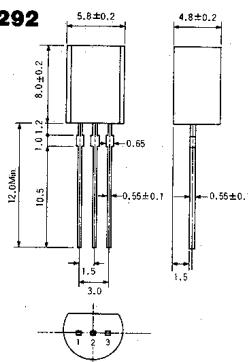


2SD1292 2SD1293M



●外形寸法図

2SD1292



☒ 1 JEDEC : TO-92L
EIAJ : SC-51

2SD1293M

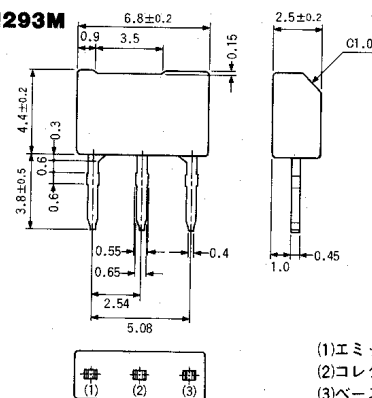


图 2 ATR

(單位:mm)

- (1)エミッタ
- (2)コレクタ
- (3)ベース

●特長

- 1) $V_{CE0} = 80V$ と高い。
- 2) $I_C = 1A$ DC と大きい。
- 3) h_{FE} のリニアリティが良い。
- 4) $V_{CE(sat)}$ が低い。

●用途

中電力出力
高耐圧ドライバー

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記 号	最大定格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	1	A
		2	A (Pulse)*
コレクタ損失	P_C	900 1	mW (2SD1292) W (2SD1293M)
接合部温度	T_j	135	°C
保存温度	T_{stg}	-55~135	°C

* $P_w=20\text{ms}$, $\text{duty}=1/2$

●電氣的特性 (Ta=25℃)

項 目	記 号	Min.	Typ.	Max.	単位	条 件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CE0}	80	—	—	V	I _C =1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	120	—	—	V	I _C =50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EB0}	5	—	—	V	I _E =50μA
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	—	—	1.0	μA	V _{CB} =100V
エミッタしゃ断電流	I _{EB0}	—	—	1.0	μA	V _{EB} =4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	0.15	0.4	V	I _C /I _B =500mA/150mA*
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE}	82	—	390	—	V _{CE} /I _C =3V/500mA*
利 得 帯 域 幅 積	f _T	—	100	—	MHz	V _{CE} /I _E =10V/50mA
出 力 容 量	C _{ob}	—	20	—	pF	V _{CB} =10V, f=1MHz

※パルス測定

hFEの値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
hFE	82~180	120~270	180~390